

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成30年1月11日(2018.1.11)

【公表番号】特表2015-507672(P2015-507672A)

【公表日】平成27年3月12日(2015.3.12)

【年通号数】公開・登録公報2015-016

【出願番号】特願2014-549290(P2014-549290)

【国際特許分類】

C 0 9 K 19/34 (2006.01)

C 0 9 K 19/12 (2006.01)

C 0 9 K 19/42 (2006.01)

C 0 9 K 19/18 (2006.01)

C 0 9 K 19/20 (2006.01)

C 0 9 K 19/30 (2006.01)

C 0 9 K 19/32 (2006.01)

G 0 2 F 1/13 (2006.01)

【F I】

C 0 9 K 19/34

C 0 9 K 19/12

C 0 9 K 19/42

C 0 9 K 19/18

C 0 9 K 19/20

C 0 9 K 19/30

C 0 9 K 19/32

G 0 2 F 1/13 5 0 0

【誤訳訂正書】

【提出日】平成29年11月24日(2017.11.24)

【誤訳訂正1】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0 0 7 3

【訂正方法】変更

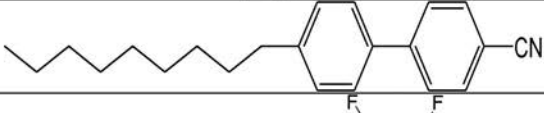

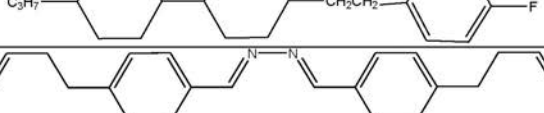
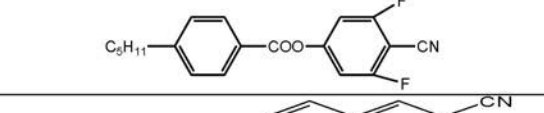
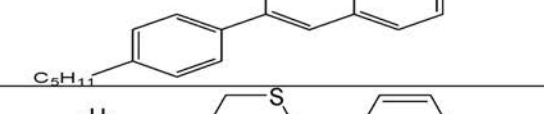
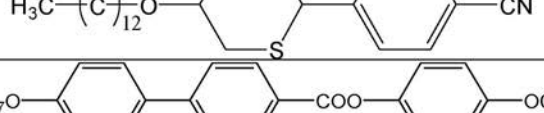
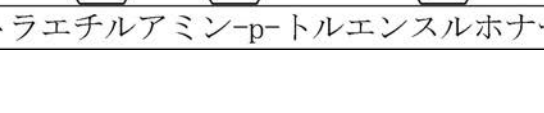
【訂正の内容】

【0 0 7 3】

実施例4：スメクチックC相を用いて混合してスメクチックC相高散乱混晶を得る。

【表 10】

表 10 実施例 4 の混晶の組成処方

| 材料 | 含有量 wt% |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  | 20 |
|  | 10 |
|  | 5 |
|  | 10 |
|  | 5 |
|  | 19.9 |
|  | 25 |
| テトラエチルアミン-p-トルエンスルホナート | 0.1 |

【誤訳訂正 2】

【訂正対象書類名】特許請求の範囲

【訂正対象項目名】全文

【訂正方法】変更

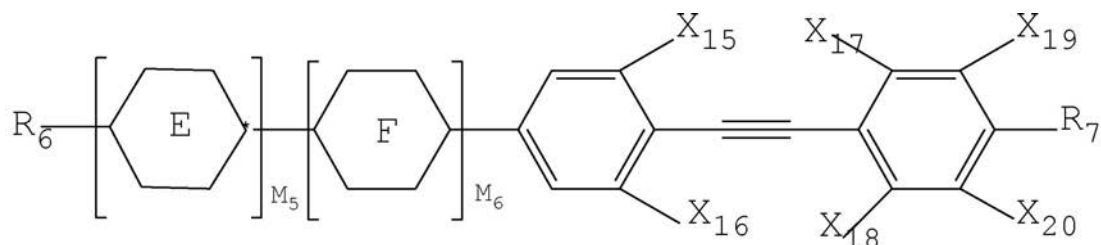
【訂正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

二種類又は二種類以上の一般式 (III), (IV), (V), 又は (VI) で表される化合物を含むことを特徴とする、高散乱スメクチック相液晶材料。

【化 1】



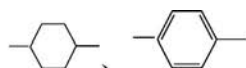
一般式 (III)

(一般式 (III) において、

R₆ は C₁-C₁₀ のアルキル基又は C₁-C₁₀ のアルコキシ基であり；R₇ は CN、NCS 又は F であり；

E、F は、独立して、

【化 2】

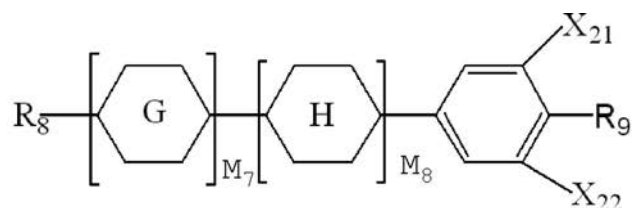


からなる群から選ばれ；

$X_{15} \sim X_{20}$ は、独立して、H又はFであり；

M_5 、 M_6 は独立して0又は1である。）

【化 3】



一般式 (IV)

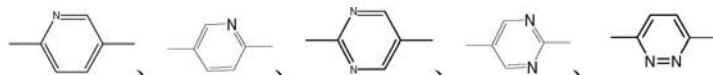
(一般式 (IV) において、

R_8 は C_1 - C_{10} のアルキル基又は C_1 - C_{10} のアルコキシ基であり；

R_9 はCN、NCS又はFであり；

G、Hは、独立して、

【化 4】

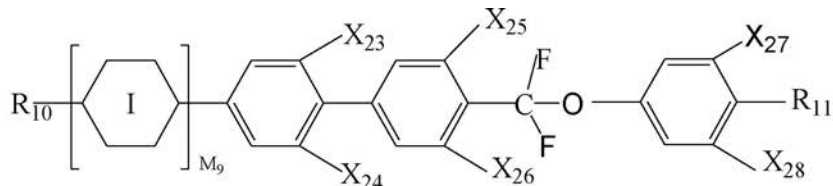


からなる群から選ばれ；

$X_{21} \sim X_{22}$ は、独立して、H又はFであり；

M_7 、 M_8 は独立して0又は1であり、且つ $M_7 + M_8 = 1$ である。）

【化 5】



一般式 (V)

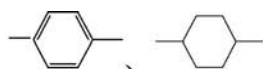
(一般式 (V) において、

R_{10} は C_1 - C_{10} のアルキル基又は C_1 - C_{10} のアルコキシ基であり；

R_{11} はCN、NCS又はFであり；

Iは、

【化 6】

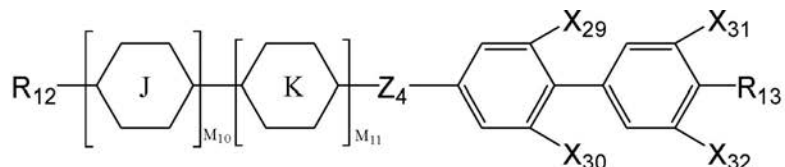


からなる群から選ばれる環構造であり；

$X_{23} \sim X_{28}$ は、独立して、H又はFであり；

M_9 は0又は1である。）

【化 7】



一般式 (VI)

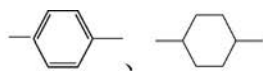
(一般式 (VI) において、

R_{12} は C_1 - C_{10} のアルキル基又は C_1 - C_{10} のアルコキシ基であり；

R_{13} はCN、NCS又はFであり；

J、Kは、

【化 8】



からなる群から独立して選ばれる環構造であり；

Z_4 は、単結合、 $-COO-$ 、 $-C_2H_4-$ 、

【化 9】



からなる群から選ばれ；

$X_{29} \sim X_{32}$ は、独立して、H又はFから選ばれ；

M_{10} 、 M_{11} は独立して0又は1である。）

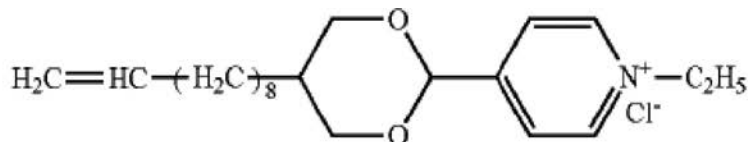
【請求項 2】

前記の高散乱スメクチック相液晶材料は、スメクチックA、B、C、D、E、F、G、H又はI相の液晶材料であることを特徴とする、請求項 1 に記載の高散乱スメクチック相液晶材料。

【請求項 3】

前記の高散乱スメクチック相液晶材料は、過塩素酸ヘキサデシルトリメチルアンモニウム、テトラブチルアンモニウムブロマイド、フェニルトリエチルアンモニウムヨード、テトラエチルアミン - p - トルエンスルホナート、ビス(テトラ - n - ブチルアミン)ビス(1, 3 - ジチオール - 2 - チオン - 4, 5 - ジチオラト)パラジウム(II)、ビス(テトラ - n - ブチルアンモニウム)テトラシアノジフェノキジメタン、過塩素酸セチルアンモニウム、セチルトリエチルアンモニウムブロマイド、1 - オクチル - 3 - メチルイミダゾリウムヘキサフルオロホスフェート、(フェロセニルメチル)トリメチルアンモニウムヨード、及び

【化 10】



からなる群から選択される少なくとも一種のイオン型化合物を含むことを特徴とする、請求項 2 に記載の高散乱スメクチック相液晶材料。

【請求項 4】

前記の高散乱スメクチック相液晶材料は、スメクチックA相材料であるか、又はスメクチックAよりも秩序度の高い非スメクチックA相材料であることを特徴とする、請求項 1 に記載の高散乱スメクチック相液晶材料。

【請求項 5】

一般式(III)、(IV)、(V)、又は(VI)で表される化合物の含有量は、混合液晶層総重量の1wt%～99.9999wt%であり、前記イオン型化合物の含有量は、混合液晶層総重量の0.0001wt%～10wt%であることを特徴とする、請求項 3 に記載の高散乱スメクチック相液晶材料。

【請求項 6】

ポリエステル系材料、ポリスチレン系高分子材料又はガラス製の、スペーサーボール、スペーサーロッド、プレポリマー、又は二色性染料が、前記高散乱スメクチック相液晶材料に添加されることを特徴とする、請求項 1 に記載の高散乱スメクチック相液晶材料。

【請求項 7】

請求項 1 に記載の高散乱スメクチック相液晶材料を含むデバイス。